

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 29 ноября 2011 года N 748

Об утверждении Правил рассмотрения и регистрации авторских договоров на объекты авторского права, договоров в области объектов смежных прав, договоров о передаче прав на топологии интегральных микросхем, Правил оформления, составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию топологии интегральной микросхемы, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию объекта авторского права и объекта смежных прав

В соответствии с законами Кыргызской Республики "[Об авторском праве и смежных правах](#)", "[О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных](#)" и "[О правовой охране топологий интегральных микросхем](#)" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- [Правила](#) рассмотрения и регистрации авторских договоров на объекты авторского права, договоров в области объектов смежных прав, договоров о передаче прав на топологии интегральных микросхем;
- [Правила](#) оформления, составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию топологии интегральной микросхемы;
- [Правила](#) составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию объекта авторского права и объекта смежных прав.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликовано в приложении к газете "Эркин Тоо" "Нормативные акты Правительства Кыргызской Республики" от 29 декабря 2011 года N 23-24 (404-405)

**Премьер-министр
Кыргызской Республики**

А.Атамбаев

ПРАВИЛА оформления, составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию топологии интегральной микросхемы

Настоящие Правила регламентируют порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию топологии интегральной микросхемы в соответствии с [Законом](#) Кыргызской Республики "О правовой охране топологий интегральных микросхем".

1. Подача заявки

1. Автор топологии или иной правообладатель может по своему желанию зарегистрировать топологию в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности (далее - Кыргызпатент) путем подачи заявки.

2. Заявка должна относиться к одной топологии.

3. Заявка на регистрацию топологии базового матричного кристалла может включать материалы, относящиеся как к топологии самого базового матричного кристалла, так и к топологии заказных интегральных микросхем, реализуемых на его основе.

4. Лица, имеющие право на подачу заявки.

Правом на подачу заявки и регистрацию топологии имеют автор или любой правообладатель (далее заявитель).

Заявка подается непосредственно заявителем либо через представителя. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5. Процедура подачи заявки.

Заявка подается в срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место.

Заявка подается в Кыргызпатент непосредственно или направляется по почте.

6. Заявка должна содержать:

- заявление на официальную регистрацию топологии интегральных микросхем (далее - ТИМС) с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть указанным в качестве такового, их местонахождения (местожительства), даты первого использования топологии, если оно имело место;

- депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат с указанием оригинальности топологии;

- схему пространственно-геометрического расположения элементов топологии интегральных микросхем;

- документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора в установленном размере или основание для освобождения от уплаты регистрационного сбора, а также уменьшение его размера.

Документы, прилагаемые к заявке:

- заверенная копия документа, подтверждающая дату первого использования топологии в коммерческих целях, если эта топология использовалась в коммерческих целях ранее даты ее подачи в Кыргызпатент;

- надлежаще заверенная копия документа, подтверждающая передачу имущественных прав, если правообладатель не является автором;

- надлежаще оформленная доверенность на представительство, если заявка подается через представителя.

7. Документы заявки представляются на государственном или официальном языке. Если документы заявки представлены на ином языке, то к ним прилагается надлежаще заверенный перевод на государственный или официальный язык депонируемых материалов.

8. Документы заявки представляются в одном экземпляре.

2. Содержание и оформление документов заявки

9. Требования к оформлению документов заявки.

Документы заявки оформляются таким образом, чтобы их можно было непосредственно репродуцировать фотографически, электростатически, офсетно и микрофильмировать.

Документы заявки выполняются на листах прочной, белой, гладкой, непрозрачной, не глянцевой бумаги формата А4 (210x297 мм) и начинаются на отдельных листах, если их установленной формой не предусмотрено иное. Размеры полей на листах документов заявки должны быть не менее (мм):

- левое - 20;

- верхнее - 17;

- правое и нижнее - 7.

В каждом документе заявки второй и последующие листы пронумеровываются арабскими цифрами и отпечатаны шрифтом черного цвета.

10. Заявление на официальную регистрацию топологии интегральной микросхемы представляется по форме КТ ([приложение 1](#) к настоящим Правилам).

Фамилии, имена и отчества (если имеются) в документах заявки на регистрацию указываются в именительном падеже.

Иностранные имена и названия предприятий указываются в кыргызской или русской транслитерации.

Графы заявления, расположенные над словом "Заявление", предназначены для внесения реквизитов после поступления заявки в Кыргызпатент и заявителем не заполняются.

В графе "Заявитель(и)" указывается полное имя или наименование заявителя, его местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве автора - заявителя указываются в графе "Автор".

Графа "Основания возникновения прав на данное произведение" заполняется в случае, когда заявитель не является автором. В ней путем простановки знака "X" в соответствующей клетке указывается правообладатель.

В графе "Название интегральной микросхемы с данной топологией" указывается сокращенное и полное название топологии.

Графа "Альтернативное название" заполняется в том случае, если существует дополнительное название для регистрируемой топологии, под которым мог быть ранее записан документ, относящийся к топологии.

В графе "Сведения о ближайшем аналоге данной топологии" приводится аналог, если таковой имеется. В качестве аналога может быть указана топология, как не использованная, так и использованная ранее в коммерческих целях. В последнем случае в графе "Дата и место первого использования топологии в коммерческих целях" указывается полная дата (число, месяц, год) и страна первого использования этой топологии в коммерческих целях.

В графе "Данные о правообладателе на дату первого использования данной топологии в коммерческих целях" приводятся сведения о ее правообладателе на дату первого использования.

В графе "Сведения об охраняемых топологиях" приводятся сведения о топологиях, используемых при создании представленной на регистрацию топологии. В понятие охраняемой топологии входит как зарегистрированная, так и незарегистрированная топология, используемая в коммерческих целях не более двух лет. Это могут быть ближайшие аналоги заявляемой топологии, а также входящие в заявляемую топологию иные топологии, состоящие из элементов, общеизвестных разработчикам и изготовителям ТИМС на дату ее создания, совокупность которой является оригинальной. Приводятся сведения о топологиях базового матричного кристалла и о топологиях заказных интегральных микросхем, созданных на его основе.

В графе "Автор" указываются фамилия, имя, отчество (если имеется) автора в именительном падеже, в указанной последовательности, дата рождения, гражданство и адрес местожительства автора, включая официальное наименование страны, телефон.

В этой же графе приводится краткое описание творческого вклада автора в создание данного произведения.

Если авторов несколько, то необходимо заполнение формы КТ/ДОП ([приложение 2](#)) с указанием объема конкретного вклада каждого автора в создание данной топологии.

Графы "Документы заявки" и "Документы, прилагаемые к заявке" заполняются путем простановки знака "X" в соответствующих клетках.

В графе "Депонируемые материалы" отмечается вид материала, идентифицирующего данную топологию.

В графе "Сведения об адресате" указываются сведения об адресате, которому следует отправлять корреспонденцию по данной заявке, т.е. указывается адрес, имя или наименование одного из заявителей, удовлетворяющие обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, телекса, факса (если имеются).

В последней графе заявления подтверждается, что указанные в заявлении сведения являются достоверными и соответствуют депонируемым идентифицирующим материалам. Графа подписывается заявителем или его представителем с указанием даты подписания. Подпись и дата обязательны. Подпись расшифровывается с указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

При подаче заявки на регистрацию от двух и более заявителей бланк заявления подписывается каждым из них, а переписка ведется с представителем, уполномоченным на это заявителями, по адресу, указанному в соответствующей графе заявления.

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации, с указанием его должности, подпись расшифровывается и скрепляется печатью.

11. Требования к оформлению депонируемых материалов.

Материалы, представляемые в Кыргызпатент на депонирование, должны обеспечивать однозначную идентификацию регистрируемой топологии.

В целях идентификации топологии, не использованной в коммерческих целях до даты подачи заявки на регистрацию, депонируемые материалы заявки должны содержать: полный комплект одного из следующих видов визуально воспринимаемых материалов, отображающих каждый слой топологии, в одном экземпляре:

- фотошаблоны;
- сборный топологический чертеж;
- послойные топологические чертежи;
- фотографии каждого слоя топологии, зафиксированной в ТИМС;
- реферат, содержащий сведения, предназначенные для последующей публикации в официальном бюллетене:
 - наименование ТИМС;
 - наименование заявителя;
 - область применения, назначение или функции ТИМС;
 - вид применяемой для изготовления ТИМС технологии.

Средний объем текста реферата до 1500 печатных знаков.

В целях идентификации топологии, использованной в коммерческих целях до даты подачи заявки на регистрацию, депонируемые материалы заявки должны дополнительно содержать образцы ТИМС, включающие данную топологию, в том виде, в котором она была использована в коммерческих целях, а в реферате - содержаться сведения о дате первого использования в коммерческих целях и об основных характеристиках образца ТИМС.

Графические изображения топологических чертежей выполняются на кальке или гладкой белой бумаге. Формат листов в сложенном виде должен быть 210x297 мм. Минимальные поля листа графического изображения должны иметь размеры: сверху и левая сторона - 20 мм, правая сторона - 15 мм, снизу - 10 мм.

Изображения на фотографиях должны быть контрастными.

На всех экземплярах чертежей и фотографий указывается масштаб изображений.

В визуально воспринимаемых материалах изображения представляются в масштабе не менее 20:1.

Образцы ТИМС, включаемые в состав заявки, должны допускать возможность получения с них визуально воспринимаемого изображения каждого слоя ее топологии.

Если какой-либо слой топологии содержит сведения конфиденциального характера (например, относящиеся к "ноу-хау"), в визуально воспринимаемых материалах соответствующая часть этого слоя (или целиком слой) может быть изъята и включена в состав депонируемых материалов, идентифицирующих топологию, в закодированной форме.

3. Рассмотрение заявки

12. Поступившим в Кыргызпатент материалам заявки присваивается входящий номер и фиксируется дата их поступления.

Заявителю либо его представителю выдается справка о принятии материалов заявки, с указанием входящего номера, даты поступления и перечня принятых документов.

13. Рассмотрение заявки производится в течение шести месяцев.

Поступившие материалы заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего уплату регистрационного сбора за подачу и рассмотрение заявки в установленном размере.

При отсутствии такого документа, заявитель уведомляется о необходимости его представления до истечения двух месяцев с даты поступления заявки при условии уплаты дополнительного сбора.

В течение двух месяцев после поступления заявки в Кыргызпатент заявитель вправе дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

14. В ходе рассмотрения заявки устанавливается:

- соответствие суммы уплаченного регистрационного сбора установленным размерам;
- наличие необходимых документов, определенных пунктом 6 настоящих Правил;
- правильность оформления документов заявки в соответствии с требованиями пунктов 9-11 настоящих Правил;
- соответствие заявленной топологии объектам, которым предоставляется правовая охрана.

По заявке, поданной с нарушением установленных требований, Кыргызпатент направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев с даты получения запроса устранить имеющиеся недостатки.

15. Если в результате рассмотрения заявки установлено, что она оформлена на объект, которому предоставляется правовая охрана, выносится решение об официальной регистрации топологии, о чем заявитель уведомляется.

Кыргызпатент, при положительном результате проверки вносит соответствующую запись в Реестр топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики, публикует в установленном

порядке сведения о зарегистрированной топологии в официальном бюллетене Кыргызпатента "Интеллектуалдык менчик", выдает заявителю свидетельство об официальной регистрации.

16. Если в результате рассмотрения заявки установлено, что она оформлена на объект, которому не предоставляется правовая охрана, и в случае несоблюдения заявителем требований абзаца два пункта 5 настоящих Правил, т.е. в случае превышения им установленных сроков подачи заявки на регистрацию с даты первого использования топологии в коммерческих целях (два года), выносится решение об отказе в официальной регистрации топологии с приведением соответствующего обоснования.

В случае отказа в регистрации заявки уплаченный сбор и материалы заявки заявителю не возвращаются.

Приложение 1

Форма КТ

**Уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности
(Кыргызпатент)**

Адрес:

Дата поступления ___ число _____ месяц _____ год

Входящий N _____

N официальной регистрации _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на официальную регистрацию топологии интегральной
микросхемы (ТИМС)**

Представляя указанные ниже документы, прошу произвести регистрацию топологии

1. Заявитель(ли)

(полное имя или наименование и местожительство или местонахождение)

Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе (9).

2. Основания возникновения прав на данную топологию (если заявитель не является автором):

заявитель является работодателем автора;

передача прав автором или его правопреемником иному лицу;

передача прав работодателем иному лицу;

право наследования.

3. Название интегральной микросхемы с данной топологией (сокращенное и полное):

4. Альтернативное название

5. Сведения о ближайшем аналоге данной топологии

6. Дата и место первого использования топологии в коммерческих целях

_____ число _____ месяц _____ год

страна _____

7. Данные о правообладателе на дату первого использования данной топологии в коммерческих целях (имя, наименование, гражданство, адрес, телефон)

8. Сведения об охраняемых топологиях (использованных при создании данной топологии)

9. Автор (для указания данных о других авторах необходимо заполнение формы КТ/ДОП)

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения _____ число _____ месяц _____ год

Гражданство _____

Адрес местожительства,
телефон

Краткое описание
авторского вклада в данное произведение

10. Депонируемые материалы, идентифицирующие данную топологию:

полный комплект одного из следующих видов визуально воспринимаемых материалов, отображающих

каждый слой данной топологии, включая спецификацию, в _____ экз.:

фотошаблоны _____ шт.;

сборный топологический чертеж на _____ л.;

послойные топологические чертежи на _____ л.;

фотография каждого слоя топологии, зафиксированной в интегральной микросхеме _____ шт.;

схема пространственно-геометрического расположения элементов топологии ИМС, на _____ л.;

образцы интегральной микросхемы, включающие данную топологию в том виде, в котором она была

использована в коммерческих целях, в _____ экз.;

реферат, в _____ экз.

11. Документы, прилагаемые к заявлению:

документ об уплате регистрационного сбора;

документ об освобождении от уплаты регистрационного сбора или уменьшении его размера;

копия документа о передаче имущественных прав;

копия документа, подтверждающего дату и место первого использования топологии в коммерческих

целях;

доверенность представителя правообладателя;

перевод на государственный или официальный язык

12. Сведения об адресате (которому следует отправлять корреспонденцию по данной заявке) адрес,

включая почтовый индекс:

- номер телефона, включая международный код (факс, телефакс и др.);

- получатель.

Я, _____

(Должность)

(Фамилия, имя, отчество)

настоящим подтверждаю, что указанные в заявлении сведения являются верными и соответствующими

депонируемым идентифицирующим материалам.

Подпись _____ "___" _____ 201__ г.

Примечание: (при подписании от имени юридического лица указывается должность руководителя, а его

подпись удостоверяется печатью).

Приложение 2

Форма КТ/ДОП

**Уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности
(Кыргызпатент)**

Адрес:

Дата регистрации

число _____ месяц _____ год _____

Входящий N _____

N официальной регистрации _____

Заявитель (полное имя или наименование одного

из заявителей, указанных в Форме КТ)

Название произведения (указанное в Форме КТ)

Дополнение к графе 9 Формы КТ

Автор

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения _____ число _____ месяц _____ год

Гражданство _____

Адрес местожительства, телефон

Краткое описание авторского вклада в данное произведение

Дополнение к графе 9 Формы КТ

Автор

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения _____ число _____ месяц _____ год

Гражданство _____

Адрес местожительства, телефон

Краткое описание авторского вклада в данное произведение

Дополнение к пункту 9 Формы КТ

Автор

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения _____ число _____ месяц _____ год

Гражданство _____

Адрес местожительства, телефон

Краткое описание авторского вклада в данное произведение

Дополнение к графе 9 Формы КТ

Автор

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения _____ число _____ месяц _____ год

Гражданство _____

Адрес местожительства, телефон

Краткое описание авторского вклада в данное произведение

Дополнение к графе 9 Формы КТ

Автор

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения _____ число _____ месяц _____ год

Гражданство _____

Адрес местожительства, телефон

Краткое описание авторского вклада в данное произведение